

КТ645

кремниевый биполярный
эпитаксиально-планарный
п-р-п транзистор

Назначение

Транзистор п-р-п кремниевый эпитаксиально-планарный в пластмассовом корпусе предназначен для использования в радиоэлектронной аппаратуре, изготавливаемой для народного хозяйства

Зарубежные прототипы

- прототипы BC547, BC238

Номер технических условий

- аАО.336.333 ТУ

**Корпусное исполнение**

- пластмассовый корпус КТ-26 (ТО-92)

Назначение выводов

Вывод	Назначение
№1	Эмиттер
№2	База
№3	Коллектор

Таблица 1. Основные электрические параметры КТ645

Параметры	Обозначение	Ед. измер	Режимы измерения	Min	Max
Граничное напряжение коллектор - эмиттер КТ645Б	Укэо гр.*	В	Ik= 10mA, Ib=0	30	
Обратный ток коллектора	Ikбо	мкА	Укб=40 - 60В, Iэ=0		10
Статический коэффициент передачи тока КТ645А КТ645Б	h21E		Укб=2В, Iэ=150mA Укб=10В, Iэ=2mA	20 80	200
Напряжение насыщения коллектор- эмиттер КТ645А КТ645Б	Укэ(нас)	В	Ik=150mA, Ib=15mA Ik=10mA, Ib=1mA		0,5 0,05
Напряжение насыщения база - эмиттер	Убэ(нас)*	В	Ik=150mA, Ib=15mA		1,2
Время рассасывания КТ645А	trас	нс	Ib1=Ib2=15mA, Ik=150mA		50
Емкость коллекторного перехода	Ск	пФ	Укб=10В, f=10МГц		5
Граничная частота коэффициента передачи тока	frp *	МГц	Укэ=10В, Ik=50mA	250	
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте	τк *	пс	Укб=5В, Iэ=5mA, f=5МГц		120

* Справочные параметры

Таблица 2. Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации КТ645

Параметры	Обозначение	Ед. измер.	Значение
Напряжение коллектор-база КТ645А КТ645Б	Укб max	В	60 40
Напряжение коллектор-эмиттер КТ645А КТ645Б	Укэг max	В	50 40
Напряжение эмиттер-база КТ645А КТ645Б	Уэб max	В	4 5
Постоянный ток коллектора	Ik max	mA	300
Импульсный ток коллектора (ti ≤ 10 мс, Q ≥ 5)	Iки max	mA	600
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора	Pк max	мВт	500
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора	Pи max	мВт	1000
Температура перехода	Tп	°C	150